cERLのオプティクス設計の進捗状況

ERL検討会 4号館 セミナーホール 2011年2月15日(水)14:00 ~

加速器第7研究系 島田 美帆、宮島 司、原田 健太郎、坂中 章悟、小林 幸則 東京大学物性研究所 中村 典雄 日本原子力研究開発機構 羽島 良一



- 1. 周長補正のためのステアリング配置
 - 5 mm~数cm程度の調整が可能。
- 2. 外側ループ周長補正のためのラティス変更
 - 内側ループと同様にベンドの位置調整で5cm程度の周長補正ができるようにラティスを変更
- 3. 35MeV-versionでエネルギー回収直後で5MeVビームを周回部から取り出し
 - 5MeVビームが周回部に残っていると、35MeVビームの収束が困難なため。
- 4. ダンプの配置およびダンプライン
 - ベンドを間に挟み、ダンプ設置後も取り出し点の位置の微調節が可能となった。
- 5. 直線部のQの配置(特に35MeV-version)
 - 加速空洞がない部分にQを追加。
 - 逆Compton散乱用に収束点近くにQを配置し、その部分以外ではQを均等に配置。

2 loop cERLのOptics設計の現状





図1: Case 2は1周目の内側ループですでに 規格化エミッタンスが10倍近くまで増加。



図2: Case2の1周目内側ループの Return arcの直前のPhase Space

現在のOpticsの問題点

Case 1 : 入射器のOpticsと整合がとれていない。 Case 2: CSR wakeによってエミッタンスが10倍も増加する。 エネルギー回収直後のビームサイズがCase1のおよそ2~3倍。

内側ループのCSR wakeによるエミッタンス増加

エミッタンス増加はアークCenterの β_x に大きく依存



図: 内側ループ半周後のエミッタンス増加。m11はある TripletのK値の組み合わせ。 運動エネルギー35MeV, バンチ長3ps, $\varepsilon_{nx} = 0.3$ mm-mrad, 電荷量77pCである。トラッキング粒子数は10000。

 $\Delta \varepsilon_{nx}$ が2倍以下に抑えられる範囲は1 m < β_x^{Cent} < 20 m

- Case 2でエミッタンスが大きくなったのは $\beta_x^{\text{Cent}} = 190 \text{ mであったためと推定できる}$ 。
- 今後は適切な範囲内に収める。



1 loop 35 MeV のOptics設計の現状



- CSR wakeによるエミッタンス増加を最小に抑えるため、アーク中央のβ関数を5mとした。
- Dump lineで分散関数を閉じなかった理由は、β関数が大きくなってしまうためである。
- 逆Compton散乱用のQは未使用である。

β関数の定義: $\sigma_{x,y} \approx \sqrt{\frac{\beta_{x,y} \varepsilon_{nx,ny}}{\gamma}}$ 規格化エミッタンス・ビームサイズに変化がない場合、 β関数はエネルギーに比例する。

定義により、5MeVではβ関数が小さくなる傾向にあるが、ビームサイズが小さいとは限らない。

Trackingの結果 35MeV, 77pC, $\varepsilon_n = 0.3$ mm-mrad, $\sigma_z = 3$ ps, particle = 1E6 Cavity 6E-4 [m] 8E-6 [m] 3E-3 [m] $\sigma_{\underline{1}}$ ⁸х,п σ_3 arc 6×10-4 arc arc arc 2.040 arc arc E 4×10-E - **M**alant Б 1.04 0 2×10* 5.04 0 s (m) s (m) s (m) ϵ_{nx} σ_x σ_v 10 mm 4 mm



減速中の空洞内

x (m)

0

2×10-3

- 最大ビームサイズ 減速空洞内: $\sigma_x=0.87$ mm ダンプライン: σ_x =3.1mm
- 最大の_{Enx}
 - 周回部(arc以外):6E-7
 - ダンプライン:7E-6
 - ダンプラインで10倍に悪化
- 垂直方向のrmsビームサイズは 1mm以下となった。

ダンプライン

8410-6

6×10*

(L) 4×10-6

2×10**



Trackingの結果(規格化エミッタンス:ε_{nx})

35MeV, particle = 1E4 (1E6の結果と若干異なる。)



• 電荷量依存性:

電荷量が大きいほどε_{nx}増加が著しい。電荷量の2乗に比例する。

初期ε_{nx}依存性:

初期ɛn,が小さいほどCSR wakeの影響が大きくなるため、ɛn,がより増加する。

バンチ長依存性:

•

バンチ長が短いほど、ε_{nx}がより増加する。その影響は初期ε_{nx}が小さいほど大きい。 RF cavityの振幅・位相の0.1%の誤差:

ε_{nx}に関しては3%程度の変化



電荷量依存性:

電荷量が大きいほどσ_xの増加が著しい。Opticsにも依存するため、電荷量の2乗に比例しない。

初期ε_{nx}依存性:

初期ɛnxが小さいほどCSR wakeの影響が大きくなるため、σxがより増加する。

バンチ長依存性:

バンチ長が短いほど σ,がより増加する。

ε_{nx}とは異なり、バンチ長に依らず初期ε_{nx}が小さいときに増加量が大きい。

• RF cavityの振幅・位相の0.1%の誤差:

σ_xに関しては4%程度の変化

まとめ

- 2つのラティスの設計を進めている。
 - 周長補正などを考慮に入れたラティスの変更を行った。(詳細は別の打ち合わせの資料を参考)
 - 35MeV運転時には、5MeVビームをエネルギー回収直後に取り出す。
- 2 loop-ERL
 - 入射合流部のTwiss parameterを入射器のOpticsを合せたところ、CSR wakeの 影響が大きくなった。
 - アーク中央のβ関数が1m~20mのから大きく外れていたことが原因であると 推測した。
- 35 MeV 1 loop-ERL
 - 比較的エネルギーが低いため、CSR wakeの影響が大きい。
 - エミッタンスやビームサイズは以下の条件で増加してしまう。
 - 短いバンチ長(1ps)、小さな初期エミッタンス(0.3mm・mrad)、大きな電荷量(77pC)
 - 77pC, 1ps, 0.3mm・mradのケースでは水平方向のビームサイズが全幅で4cmを超えることもある。